



การศึกษากลไกการเคลื่อนตัวของทองในระดับอะตอม ในการเปลี่ยน  
โครงสร้างทางพื้นผิวของฟิล์มทองที่ผลิตจากทองคำเปลว

Mechanism of atomic transport on gold film fabricated by  
gold leaf

โดย  
ภูมิรัตน์ นวรัตน์

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## บทคัดย่อ

การผลิตฟิล์มทองคำด้วยทองคำเปลวโดยใช้วัสดุฐานเป็นแก้วและซิลิกอนเพื่อใช้งานวิจัยครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากทองคำเปลวไม่สามารถยึดเกาะกับวัสดุฐานได้ดีพอ ดังนั้นการผลิตฟิล์มทองคำด้วยเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยพิล์มบางแบบสป๊ตเตอร์ริงโดยการวางวัสดุฐานในพื้นที่ร่างของห้องตัวอย่างของเครื่องสป๊ตเตอร์ริงเพื่อผลิตตัวอย่างฟิล์มจากไอทองคำเหลือใช้จากการเตรียมตัวอย่างอื่นของเครื่องสป๊ตเตอร์ริง

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลของการอบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของตัวอย่างฟิล์มทองคำตัวอย่างฟิล์มทองคำของตัวอย่างฟิล์มถูกอบที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$ - $700^{\circ}\text{C}$  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผ่านกระบวนการรวมกันเป็นหยดในสถานะของแข็ง (Solid State Dewetting) ของฟิล์มทองคำ ซึ่งสามารถสรุปได้จากผลการทดสอบตัวอย่างฟิล์มทองคำด้วยภาพถ่ายกล้องโทรทรรศ์เคลื่อนที่ ภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และผลการวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) โดยกระบวนการรวมกันเป็นหยดจะเกิดมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และเกิดขึ้นในตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วมากกว่าฟิล์มทองคำบนซิลิกอน จากการทดสอบโครงสร้างทางผลีกของตัวอย่างฟิล์มทองคำด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ พบร้าโครงสร้างทองคำ ชนิด Au(111) Au(200) และ Au(220) ในตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้ว และโครงสร้างทองคำ ชนิด Au(111) ในตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้ว เมื่อทำการอบ ตัวอย่างฟิล์มทองคำมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณและความเป็นความเป็นผลลัพธ์เชิงเดี่ยวโครงสร้างทองคำ Au(111) ตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในการอบจาก  $300^{\circ}\text{C}$ - $700^{\circ}\text{C}$  ในตัวอย่างฟิล์มทองคำบนซิลิกอนพบลดลงของปริมาณและความเป็นความเป็นผลลัพธ์เชิงเดี่ยวโครงสร้างทองคำ Au(111) ที่อุณหภูมิการอบ  $300^{\circ}\text{C}$  และพบการเพิ่มขึ้นของปริมาณและความเป็นความเป็นผลลัพธ์เชิงเดี่ยวโครงสร้างทองคำ Au(111) ที่อุณหภูมิการอบ  $700^{\circ}\text{C}$

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของฟิล์มเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของทองคำในระดับอะตอม โดยกระบวนการรวมกันเป็นหยดที่สถานะของแข็งมีแนวโน้มเกิดจากการรับความร้อนจากการอบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางผลีกมีแนวโน้มเกิดจากการตกผลีกของทองคำในระหว่างการเย็บตัวของตัวอย่างฟิล์มทองคำ และปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของอะตอมทองคำ คือ อัตรากริยา率 ระหว่างฟิล์มทองคำและวัสดุฐาน

คำสำคัญ (TH) การรวมกันเป็นหยดที่สถานะของแข็ง การอบร้อน ฟิล์มทอง ทองคำเปลว

## Abstract

The attempt to fabricate gold films on glass slide (Au/glass) and silicon wafer (Au/Si) with gold leaf was unsuccessful due to poor adhesion between the gold leaf and substrates. Alternatively, Au/glass and Au/Si films were fabricated by placing the substrate into the free space within sputtering chamber to collect the access Au vapor during the typical sputtering process for other samples.

In this study, the physical changes were observed in both Au/glass and Au/Si film under the film annealing from  $300^{\circ}\text{C}$ - $700^{\circ}\text{C}$ . The visual inspection via cell phone camera, the micrograph via Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) revealed the morphological changes with respect the annealing temperature in Au films due to solid state dewetting mechanism. The changes were more pronounce in Au/glass films than Au/Si films at the same annealing temperature. The X-ray diffraction measurement three phases of Au including Au(111), Au(200), and Au(220) in Au/glass films and one phase of Au(111) in Au/silicon films. The concentration and single crystallinity of Au(111) were increased with respect to annealing temperature in Au/glass film. For Au/Si films, the concentration and single crystallinity of Au(111) were decreased at  $300^{\circ}\text{C}$  and then were increased at  $700^{\circ}\text{C}$ , respectively.

The physical changes of Au films are likely due to the movement of Au atoms via solid state dewetting and recrystallization. The heat intake from annealing process is likely induced the dewetting process by increasing the kinetic energy of Au atoms. While the recrystallization process is likely occur during the cooling period of the samples. Finally, another factor that can affects the physical changes of Au films is the interface interaction between Au films and substrates.

คำสำคัญ (EN) solid state dewetting, annealing, gold film, gold leaf

# กิตติกรรมประกาศ

คณบุรุษวิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้การสนับสนุน บุคลกร และสถานที่ในการทำงานวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ดี โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับจากทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณบุรุษวิจัย



# สารบัญ

บทคัดย่อ .....	ก
Abstract .....	ข
กิตติกรรมประกาศ .....	ค
สารบัญ .....	ง
บัญชีตราง .....	ฉ
บัญชีรูปภาพ .....	ช
บทที่ 1 บทนำ .....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย .....	2
ขอบเขตของการวิจัย .....	2
วิธีดำเนินการวิจัย .....	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	4
การประมาณขนาดเฉลี่ยของ grain ด้วยสูตรของ Scherrer .....	4
กระบวนการ solid state dewetting .....	5
การเปลี่ยนโครงสร้างผลึกและขนาดของเกรน เนื่องจากความร้อน (Tesler 2013)[3] .....	6
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย .....	7
การเตรียมฟิล์มทองจากทองคำเปลว .....	7
การเติมฟิล์มทองจากการเคลือบในสุญญากาศ sputtering .....	7
การอบฟิล์มทอง annealing ของฟิล์มทองจากทองคำเปลว .....	9

การอบฟิล์มทอง annealing ของฟิล์มทองจากเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยฟิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริ่ง (Sputter Coater) .....	10
การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด .....	10
การวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) .....	11
การวิเคราะห์โครงสร้างทางพลีกด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ .....	11
บทที่ 4 ผลการวิจัย .....	13
ผลการผลิตฟิล์มทองจากทองคำเปลว.....	13
ภาพถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวอย่างฟิล์มทองคำที่ผลิตด้วยเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยฟิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริ่ง (Sputter Coater).....	14
ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของของตัวอย่างฟิล์มทองคำที่ผลิตด้วยเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยฟิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริ่ง (Sputter Coater) .....	16
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) ....	18
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางพลีกของฟิล์มทองคำบนแก้วด้วยเทคนิค .....	20
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางพลีก ของ ฟิล์มทองคำบนชิลิกอน .....	22
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .....	25
เอกสารอ้างอิง .....	27
ประวัตินักวิจัย .....	28

# บัญชีตาราง

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว แสดงการลดลงของความเข้มข้นของทองคำเมื่ออุณหภูมิในการอบต่างๆ.....	18
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกา แสดงการลดลงของความเข้มข้นของทองคำเมื่ออุณหภูมิในการอบต่างๆ.....	19
ตาราง 3 สรุปค่าตำแหน่งจุดศูนย์กลางของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว .....	21
ตาราง 4 สรุปค่าความกว้างเต็มสูงสุดครึ่งหนึ่งของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว .....	21
ตาราง 5 สรุปค่าพื้นที่ใต้กราฟของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว .....	21
ตาราง 6 สรุปค่าตำแหน่งจุดศูนย์กลางของยอดของ Si(100) ที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอน .....	22
ตาราง 7 สรุปค่าตำแหน่งจุดศูนย์กลางของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนโดยไม่ร่วมยอดของ Si(100) .....	23
ตาราง 8 สรุปค่าความกว้างเต็มสูงสุดครึ่งหนึ่งของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนโดยไม่ร่วมยอดของ Si(100) .....	23
ตาราง 9 สรุปค่าพื้นที่ใต้กราฟของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนโดยไม่ร่วมยอดของ Si(100) .....	24

# บัญชีรูปภาพ

รูป 1 เครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยฟิล์มบางแบบสปัตเตอร์ (Sputter Coater) จากบริษัท Cressington Scientific Instrument รุ่น Cressington 108auto .....	7
รูป 2 เตาอบ Carbolite ELF 11/14B Economy Chamber Furnace .....	9
รูป 3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy: SEM) จากบริษัท Thermo Scientific รุ่น phenom pro G6 .....	10
รูป 4 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer: XRD) จากบริษัท Bruker รุ่น D ADVANCE ECO .....	11
รูป 5 ภาพถ่ายตัวอย่างฟิล์มทองคำด้วยกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Samsung Galaxy A50 ก) ฟิล์มทองบนแก้วไม่อ่อน ข) ฟิล์มทองบนแก้วอบที่ $700^{\circ}\text{C}$ ค) ฟิล์มทองบนแก้วอบที่ $300^{\circ}\text{C}$ ง) ฟิล์มทองบนซิลิกอนไม่อ่อน จ) ฟิล์มทองบนซิลิกอนอบที่ $700^{\circ}\text{C}$ ค) ฟิล์มทองบนซิลิกอนอบที่ $300^{\circ}\text{C}$ .....	15
รูป 6 ภาพถ่ายของตัวอย่างฟิล์มทองคำจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ก) ฟิล์มทองบนแก้วไม่อ่อน ข) ฟิล์มทองบนแก้วอบที่ $300^{\circ}\text{C}$ ค) ฟิล์มทองบนแก้วอบที่ $700^{\circ}\text{C}$ ง) ฟิล์มทองบนซิลิกอนไม่อ่อน จ) ฟิล์มทองบนซิลิกอนอบที่ $300^{\circ}\text{C}$ ค) ฟิล์มทองบนซิลิกอนอบที่ $700^{\circ}\text{C}$ .....	16
รูป 7 ผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้ว .....	20
รูป 8 ผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างฟิล์มทองคำบนซิลิกอน .....	22

# บทที่ 1 บทนำ

## ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ท่องคำเป็นหนึ่งในโลหะมีค่า ที่อยู่คู่กับอารยธรรมของมนุษย์มานานและถูกประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องประดับ หรือ ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น เนื่องจากทองคำมีความเป็นมั่นคง สวยงาม และยังมีความคงทนไม่เกิดสนิมได้ง่าย นอกจากนี้ทองคำยังมีความเป็นพิษต่อมนุษย์ต่างสามารถนำมาประกอบอาหารเพื่อความสวยงามได้เช่นกัน นอกจากการใช้งานที่หลักที่ก่อรำข้างต้น พบว่าทองคำยังมีความสำคัญใน อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย อันเนื่องมาจาก คุณสมบัติทางการนำไฟฟ้าที่ดี

เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตของมนุษย์พัฒนาไปได้อย่างก่อรำกระโดด เหตุผลสำคัญหนึ่งคือ ความพยายามในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอิเล็กทรอนิกอย่างต่อเนื่องภายใต้กฎของมัวร์ (Moore's law) ซึ่งนำไปสู่ความพยายามในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการพัฒนานี้กำลังมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกในปัจจุบันเริ่มมีขนาดเล็กลงมากจนวัสดุเหล่านี้เริ่มได้รับผลกระทบจากการประมวลผล (quantum effect) ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแบบดั้งเดิม (classical physics) ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีความตั้มในปัจจุบันของมนุษย์ยังไม่มีมากเพียงพอต่อการนำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเพื่อการค้าเพื่อต่อยอดกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกในปัจจุบันได้ ดังนั้นมีภาระสำคัญมากที่ต้องดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกในรูปแบบใหม่มากขึ้น หนึ่งในหัวข้อวิจัยที่สำคัญ คือ การทำความเข้าใจพฤติกรรมของทองคำ เพราะทองคำนับว่าเป็นหนึ่งในวัสดุสำคัญที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกรูปแบบใหม่ในอนาคตเช่นกัน

ความเข้าใจในพฤติกรรมของทองในระดับอ่อนตัว จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการผลิตและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ใน อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม แต่ปัญหาสำคัญที่ชลอการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทองคำ คือ ต้นทุนที่สูง เนื่องจากทองคำนับว่าเป็นวัสดุที่มีราคาสูงอยู่แล้ว นอกจากนั้นทองคำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกมักเป็น ทองคำที่มีความบริสุทธิ์สูงและจำเป็นต้องผ่านกระบวนการผลิตที่จำเพาะทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นไปอีก เช่น พิล์มทองบาง ดังนั้นงานวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนการสร้าง พิล์มทองคำสำหรับงานวิจัย โดยการใช้ทองคำเปลว เนื่องจากประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตทองคำเปลว ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการพัฒนาแผ่นพิล์มทองเพื่อการวิจัย จากทองคำเปลวจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของการผลิตในไทยด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ และท้ายที่สุด งานวิจัยต้องการจะทำศึกษาทำความเข้าใจกลไกการเคลื่อนที่ของทองคำเปลว เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จะมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกต่อไป

## วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) ศึกษากลไกในการเคลื่อนตัวของ อะตอมของทองในทองคำเปลวระหว่างการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวด้วยความร้อนจากการอบ
- 2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแผ่นฟิล์มทองเพื่อการวิจัย จากทองคำเปลว

## ขอบเขตของการวิจัย

- 1) เข้าใจกลไกการเคลื่อนตัวของทอง(ในระดับอะตอม) ของทองคำเปลวระหว่างการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวด้วยความร้อนจากการอบ
- 2) ศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแผ่นฟิล์มทองเพื่อการวิจัย จากทองคำเปลว

## วิธีดำเนินการวิจัย

- 1) เตรียมตัวก่อนการทดลอง
  - a. ทบทวนวรรณกรรม
  - b. ออกแบบการทดลอง
- 2) ทำการผลิตตัวอย่างฟิล์มทองคำบนวัสดุฐานสองชนิด ได้แก่ แก้ว และ ชิลิกอน
  - a. ผลิตฟิล์มทองคำจากทองคำเปลว พบร่วมกับฟิล์มยังไม่เหมาะสมต่อการใช้ศึกษากลไกการเคลื่อนที่ของทองคำในระดับอะตอม
  - b. เตรียมฟิล์มทองจากการเคลือบในสูญากาศ sputtering
- 3) นำตัวอย่างฟิล์มทองคำไปอบ ที่อุณหภูมิต่างกัน ( $300^{\circ}\text{C}$  และ  $700^{\circ}\text{C}$ )
- 4) นำตัวอย่างฟิล์มทองคำที่อบที่อุณหภูมิต่างกันไปวิเคราะห์
  - a. ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒 Scanning Electron Microscopy (SEM)
  - b. ทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)
  - c. ทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD)
- 5) วิเคราะห์ผล
  - a. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของฟิล์มทองคำจากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒 Scanning Electron Microscopy (SEM)

- b. วิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค จากการทดสอบด้วย Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)
  - c. วิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD)
  - d. สรุปผลการทดลอง
- 6) เผยแพร่ผลงาน
- a. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
  - b. วางแผนในการเผยแพร่ผลงาน โดยการนำเสนอทางวิชาการ หรือ การบูรณาการการสอน วิชาที่เหมาะสมของสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมต่อไป

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) การเข้าใจกลไกพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของคำจะเป็นการขยายองค์ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
- 2) องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฟิล์มทองคำอาจนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมและการวิจัยทางอิเล็กทรอนิกกำลังพยายามก้าวข้ามขีดจำกัด ของความไม่แน่นอนเนื่องมาจากการระบททางควอนตัม(quantum effect)ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกมีขนาดเล็กลง
- 3) สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการการสอนได้

## บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### การประมาณขนาดเฉลี่ยของ grain ด้วยสูตรของ Scherrer

สูตรของ Scherrer เป็นสมการที่ใช้ในการประมาณขนาดเฉลี่ยของผลึกที่สนใจ หรือ ขนาดของกรน grain โดยที่สูตรของอยู่ในรูป

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} \quad \text{สมการที่ 1}$$

เมื่อ  $D$  คือ ขนาดเฉลี่ยของผลึก หรือ ขนาดเฉลี่ยของกรน

$\lambda$  คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซเรย์ที่ตัดกระหบ

$\beta$  คือ ความกว้างที่ความสูงครึ่งหนึ่งของ ยอด xrd ในหน่วย เรเดียน

$\theta$  คือ มุมของ Bragg และ

$K$  คือ ค่าคงที่

ในงานของ Scherrer เขาได้ให้ค่า  $K = 2(\ln \frac{2}{\pi})^{\frac{1}{2}} \approx 0.9394$  และต่อมาได้มีการศึกษาและพัฒนาสูตรของ Scherrer พบว่าค่าคงที่นี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลายของตัวอย่าง เช่น รูปร่างของผลึกม ค่าตัวชี้ (hkl) ของระบบการสะท้อน เป็นต้น และ หนึ่งในการศึกษาเหล่านี้ Langford และ Wilson [1] ได้ประมาณว่า  $0.70 < K < 1.70$

## กระบวนการ solid state dewetting

เมื่อหยดของไอล์บันพื้นผิว แล้วของไอลจะประพฤตัวได้สองแบบ คือ หนึ่ง ทำให้พื้นผิวเปียก wetting หรือการที่ของไอลสามารถเข้าไปครอบคลุมพื้นได้อย่างเสถียรหรือ เป็นวงกว้าง หรือ สอง การที่ของไอลทำให้พื้นผิวไม่เปียก dewetting โดยการรวมตัวกันเป็นหยด (droplet) dewetting เป็นกลไกการหลุดตัวของของไอล (fluid) จากการที่ของไอลครอบคลุมพื้นผิวที่ไม่เหมาะสมอย่างไม่เสถียร

สำหรับวัสดุประเภทฟิล์มบางส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นในสถานะ ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ มักจะอยู่ในสถานะกึ่งเสถียร (Metastable) หรือ ไม่เสถียร ดังนั้นเป็นที่คาดได้ว่าฟิล์มบางเหล่านี้จะต้องสลายตัวในที่สุด คำถามที่สำคัญคือ ฟิล์มเหล่านี้จะสลายตัวอย่างไร สำหรับฟิล์มทองคำบนซิลิโคน (Ernst และ คณะ)[2] ได้ เสนอว่า กระบวนการรวมตัวกันเป็นหยด (dewetting) คือ หนึ่งในกระบวนการที่ทำให้ฟิล์มทองคำสลายตัวจากฟิล์ม ต่อเนื่องได้ โดย กระบวนการรวมตัวกันเป็นหยด dewetting สามารถเกิดได้จากสองกลไกหลักๆ ได้แก่ การรวมตัวกันเป็นหยดจาก การณีຍวนា(induced dewetting) เห尼ຍวนា หรือ การรวมตัวเป็นหยดแบบสันหลัง (spinodal dewetting)

การรวมตัวกันเป็นหยดจากเหนីយวนា (induced dewetting) เป็นกระบวนการจ่ายๆที่ชั้นของวัสดุ ประเภทฟิล์มถูกก่อกรวนให้เกิดรู โดยรูเหล่านี้อาจเกิดจากการกระทบทางกายภาพ หรือ ความไม่แน่นอนทางสถิติ จากนั้นวัสดุในฟิล์มบางจึงเริ่มหลุดตัวจากรูเหล่านี้ โดยเริ่มรวมกันที่ขอบของรูและผลักขอบออกไปทำให้รูขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายวัสดุเหล่านี้จากหลายๆรูจะมาร่วมกันเป็นหยดในที่สุด

การรวมตัวเป็นหยดแบบสันหลัง (spinodal dewetting) เป็นกระบวนการที่เกิดจาก ความผันผวนของ ความหนาของฟิล์ม ซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของ รู และ หยด บนฟิล์มในวงกว้างอย่างพร้อมเพียงกัน โดยกลไกการรวมตัวเป็นหยดแบบสันหลัง มีสี่ขั้นตอนได้แก่ สถานะเริ่มต้นเป็นแผ่น สถานะที่หนึ่ง สถานะที่สอง และ สถานะเป็นหยด ในสถานะเริ่มต้น ฟิล์มมีการกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกันบนวัสดุฐานโดยไม่ถูกรบกวน ใน สถานะที่หนึ่ง แผ่นฟิล์มเริ่มได้รับความร้อนทำให้วัสดุฟิล์มเกิดการเคลื่อนที่แบบบราวนเนียน (Brownian motion) มากขึ้น ซึ่ง นำไปสู่การกระจายตัวของสารในรูปแบบคลื่นในมิติของตำแหน่ง โดยในสถานะที่หนึ่ง รูปแบบคลื่นนี้จะมีความเสถียรและจะหมดความเสถียรไปเมื่อเข้าสู่สถานะที่สอง ในสถานการเคลื่อนที่แบบบราวนเนียนจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งนำไปสู่ส่วนที่บ้างของฟิล์มจากสถานะที่สอง เริ่มไปสัมผัสถกับวัสดุฐานจนเกิดเป็นรูบนฟิล์ม ซึ่งรูเหล่านี้ จะขยายขนาดด้วยกลไกแบบเดียวกับการรวมตัวเป็นหยดจากการเหนីយวนា ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างกลไกทั้งสอง คือการเกิดรูในการรวมตัวเป็นหยดแบบสันหลังนี้ รูจะไม่ได้เกิดแบบชุมแต่เกิดแบบเป็นระบบขึ้นอยู่กับกระบวนการ

ตัวของسانจากการเหนี่ยวนำความร้อน (heat-induced warping) เสริมด้วยศักย์ยังผลกระทบระหว่างผิวสัมผัส (effective interfacial potential)

## การเปลี่ยนโครงสร้างผลึกและขนาดของเกรน เนื่องจากความร้อน[3]

ในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรวมกันเป็นหยดของพิล์มทองคำบนแก้วอันเนื่องจากความร้อนของ Tesler และคณะพบว่าการรวมกันเป็นหยดของพิล์มทองนอกจากรูปทรงของพิล์มทองแล้วยังมีผลต่อการเปลี่ยนโครงสร้างทางผลึกของทองคำด้วย ใน การศึกษานี้ พบร่วมกับในตัวอย่างพิล์มทองคำที่ไม่ผ่านการอบจะมีการพบทองคำในรูปแบบผลึกทั่วไปเหมือนกับ ตัวอย่างมาตรฐานทองคำ แต่เมื่อตัวอย่างพิล์มทองคำผ่านการอบแล้วพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของผลึกทองคำ (111) อย่างมีนัยสำคัญและส่งผลให้ปริมาณผลึกทองคำในรูปแบบอื่นลดลงไปด้วย



## บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

### การเตรียมพิล์มทองจากทองคำเปลว

1. ทำความสะอาด แผ่นสไลด์แก้ว หรือ แผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ ด้วย ออกซิเจน เมทานอล และ น้ำมันเชื้อ จำกนั้น เป็นตัวให้แห้งด้วยปืนลม เพื่อเป็นวัสดุฐานสำหรับเตรียมพิล์มทอง
2. แบบทองคำเปลวที่บน ขึ้นงานฐานที่ทำความสะอาด โดยพยายามให้ทองคำเปลวนขึ้นงานฐานเรียบ ที่สุด

### การเตรียมพิล์มทองจากการเคลือบในสุญญากาศ sputtering



รูป 1 เครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยพิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริง (Sputter Coater) จากบริษัท Cressington Scientific Instrument รุ่น Cressington 108auto

1. ทำความสะอาด แผ่นสไลด์แก้ว หรือ แผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ ด้วย ออกซิโตน เมทานอล และ น้ำดีไอ จากนั้น เปล่าให้แห้งด้วยปนลม เพื่อเป็นวัสดุฐานสำหรับเตรียมฟิล์มทอง
2. นำชิ้นงานฐานที่ทำความสะอาดใส่เข้าไปใน เครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยฟิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริง (Sputter Coater) จากบริษัท Cressington Scientific Instrument รุ่น Cressington 108auto
3. ทั้งนี้การเคลือบทองคำบนวัสดุฐานเพื่อผลิตฟิล์มทองคำในงานวิจัยครั้งนี้ ทำโดยไม่มีการควบคุมความ หนา เพราะ เป็นการนำวัสดุฐานวางไว้ในห้องสูญญากาศบริเวณที่ว่างระหว่าง ที่มีการเตรียมตัวอย่าง อีกๆสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนซึ่งจำเป็นต้องมีการเคลือบทองคำ ซึ่งเป็นการนำทองคำซึ่ง ปกติจะถูกเคลือบพื้นที่ว่างในห้องสูญญากาศไปอย่างเสียเปล่ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตฟิล์มทองคำ สำหรับงานวิจัยนี้



## การอบพิล์มทอง annealing ของพิล์มทองจากทองคำเปลว



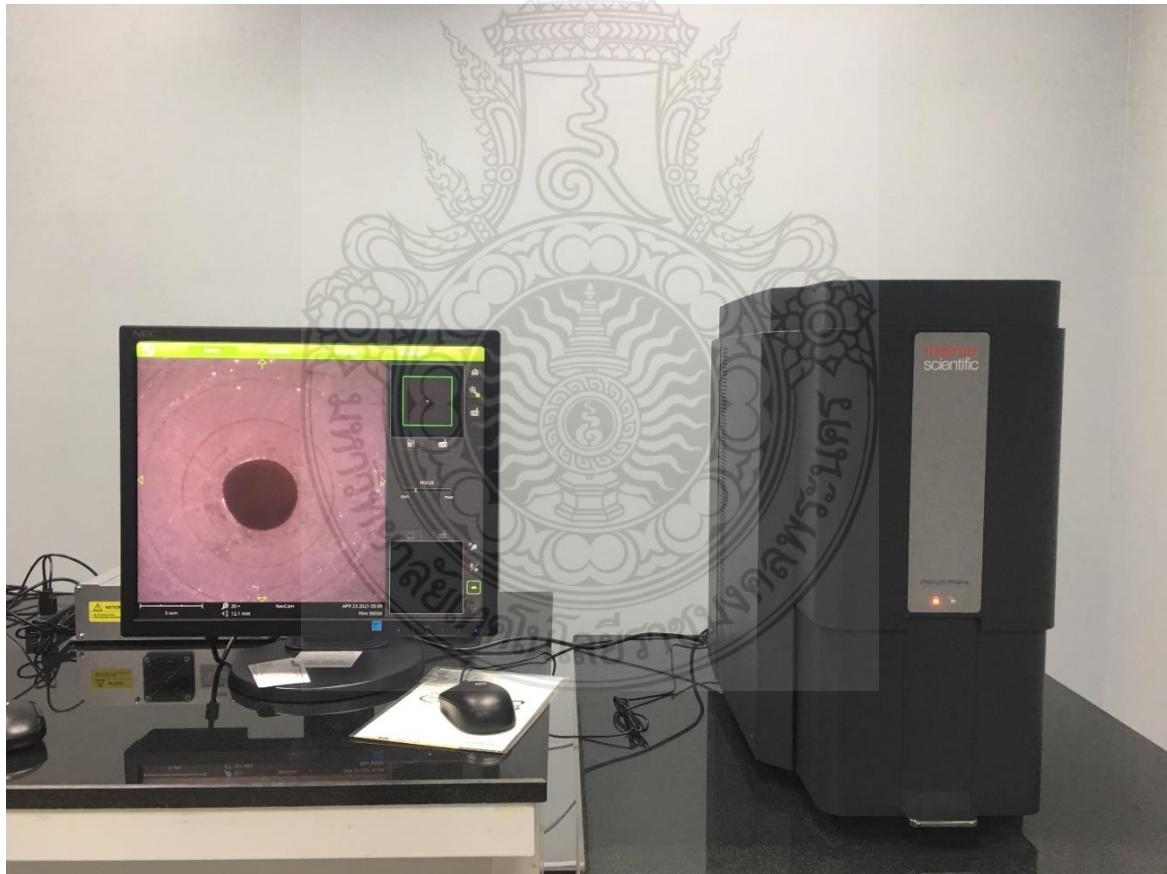
รูป 2 เตาอบ Carbolite ELF 11/14B Economy Chamber Furnace

1. นำตัวอย่างพิล์มทองคำเข้าไปอบใน เตาอบ Carbolite ELF 11/14B Economy Chamber Furnace โดยตั้งโปรแกรมในการอบดังนี้
  - a. อุณหภูมิเพิ่มจาก อุณหภูมิห้องไป 300 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราเร็ว 10 องศาเซลเซียส ต่อ ชั่วโมง
  - b. แซฟท์อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา ประมาณ 4 ชม.
2. ทำซ้ำโดยเปลี่ยนจากอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็น 500 และ 700 องศาเซลเซียส

## การอบพิล์มทอง annealing ของพิล์มทองจากเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยพิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริง (Sputter Coater)

1. นำตัวอย่างพิล์มทองคำเข้าไปอบใน เตาอบรุ่น โดยตั้งโปรแกรมในการอบดังนี้
  - a. อุณหภูมิเพิ่มจาก อุณหภูมิห้องไป 300 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราเร็ว 10 องศาเซลเซียส ต่อชั่วโมง
  - b. แข็งตัวที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา ประมาณ 4 ชม.
2. ทำขึ้นโดยเปลี่ยนจากอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็น 700 องศาเซลเซียส

## การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราด



รูป 3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscopy: SEM) จากบริษัท Thermo Scientific รุ่น phenom pro G6

- ทำการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ยี่ห้อ thermo scientific รุ่น phenom pro G6 ด้วย พลังงานอิเล็กตรอน 15kV และกำลังขยาย 10,000 เท่า

## การวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)

- ใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ยี่ห้อ thermo scientific รุ่น phenom ด้วย พลังงานอิเล็กตรอน 15kV และกำลังขยาย 10,000 เท่า ในการวิเคราะห์ธาตุของตัวอย่าง ในโหมด map

## การวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์



รูป 4 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer: XRD) จากบริษัท Bruker รุ่น D ADVANCE ECO

1. การทดสอบโครงสร้างทางผลึกของฟิล์มทองทำโดย ใช้เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer: XRD) จากบริษัท Bruker รุ่น D ADVANCE ECO
2. ทำการทดสอบตัวอย่างโดยการใช้ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้ว และฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่ ผ่านการอบที่อุณหภูมิต่าง โดยไม่ต้องมีการเตรียมตัวอย่างเพิ่มเติม



## บทที่ 4 ผลการวิจัย

### ผลการผลิตฟิล์มทองจากทองคำเปลว

จากการพิจารณาในผลิตภัณฑ์ฟิล์มทองคำแบบแก้ว และฟิล์มทองคำบนทองคำเปลวพบว่าปัญหาสำคัญ คือ การยึดติดของแผ่นทองคำเปลวนกับสตูลฐานทั้งสองประเภทไม่ว่าจะเป็น แผ่นแก้วหรือ แผ่นซิลิกอน มีน้อยมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตตัวอย่างฟิล์มทองคำจากทองคำเปลวที่มีความเสถียรมากพอที่จะนำไปอุปกรณ์การศึกษาและในการเคลื่อนที่ของทองคำได้ตามที่ต้องการได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้มีสองวิธี คือ หนึ่งการเลือกใช้สารประสานระหว่างทองคำและสตูลฐาน เช่น การใช้อิพอกซ์เรสินเป็นต้น และ วิธีที่สอง คือ การเลือกใช้กระบวนการอื่นในการผลิตฟิล์มทองคำ เช่น การใช้เครื่องเคลือบสุญญากาศ (sputtering) เป็นต้น เพื่อตัดสินเลือกแนวทางที่เหมาะสมสมผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแนวทางทั้งสองดังนี้

การใช้สารประสานระหว่างทองคำเปลวและสตูลฐาน

#### ข้อดี

- 1) มีต้นทุนต่ำกว่า
- 2) ได้ฟิล์มทองคำที่ผลิตจากทองคำเปลว

#### ข้อเสีย

- 1) การใช้สารประสานจะเพิ่มความสับช้อนให้กับระบบฟิล์มทองคำ
- 2) สารประสานที่เลือกใช้จะเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิที่สามารถอบตัวอย่างฟิล์มทองคำได้
- 3) การผลิตฟิล์มทองคำที่เรียบเป็นไปได้ยาก

การผลิตฟิล์มทองคำด้วยเครื่องเคลือบสุญญากาศ (sputter)

#### ข้อดี

- 1) ได้ตัวอย่างฟิล์มทองคำที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่าทองคำเปลว
- 2) ได้ตัวอย่างฟิล์มทองคำที่มีความเรียบ
- 3) ได้ตัวอย่างฟิล์มทองคำที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าการเตรียมฟิล์มทองคำด้วยสารประสาน จึงมีความเหมาะสมต่อการศึกษาและการเคลื่อนที่ของทองคำมากกว่า

## ข้อเสีย

- 1) ต้นทุนในการผลิตสูง
- 2) แม้ว่าจะได้ฟิล์มทองคำที่มีความบริสุทธิ์กว่า แต่จะได้ตัวอย่างที่แตกต่างจากฟิล์มทองคำจากทองคำเปลวตามที่ได้เสนอหัวข้อไว้

จากวิเคราะห์ข้อดีและเสียของหั้งสองแนวทาง ผู้วิจัยเชื่อว่าแนวทางที่สองการผลิตฟิล์มทองคำโดยใช้เครื่องเคลือบผิวในสูญญากาศมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากเป้าหมายหลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษากลไกการเคลื่อนตัวของทองในระดับอะตอม ในการเปลี่ยนโครงสร้างทางพื้นผิวของฟิล์มทองที่ผลิตจากทองคำเปลว แม้ว่าการที่ผู้วิจัยเลือกใช้ฟิล์มทองที่ผลิตจากเครื่องเคลือบผิวในสูญญากาศนั้นจะแตกต่างไปจากการตัวอย่างที่ผู้วิจัยตั้งใจไว้ แต่การใช้ตัวอย่างนี้ยังคงเป็นตัวอย่างฟิล์มทองคำที่เหมาะสมต่อการศึกษากลไกการเคลื่อนตัวของทองในระดับอะตอมมากกว่า การใช้ตัวอย่างฟิล์มทองคำจากทองคำเปลวโดยใช้สารประสานเนื่องจากมีความซับซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของทองน้อยกว่า

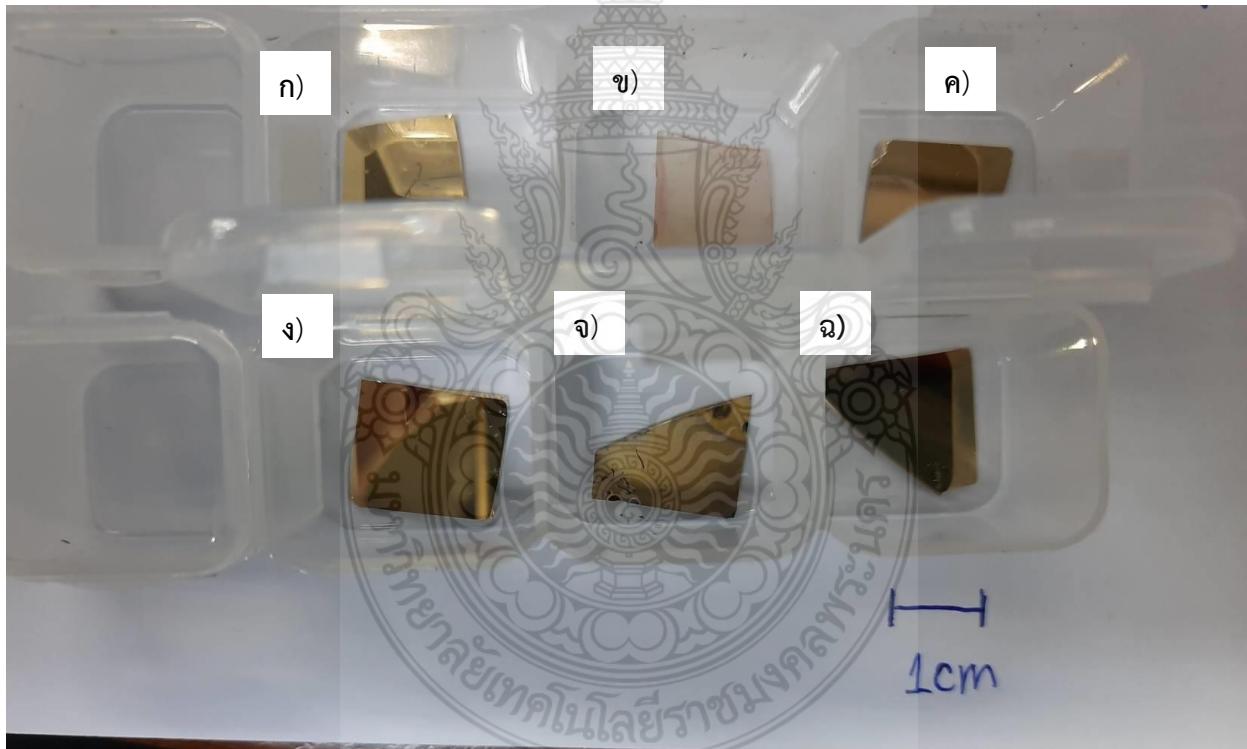
## ภาพถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวอย่างฟิล์มทองคำที่ผลิตด้วยเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยฟิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริง (Sputter Coater)

ตัวอย่างฟิล์มทองบนแก้ว: ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วควบคุม (รูปที่ 5 ก) หรือ ตัวอย่างที่ไม่ได้อบมีลักษณะความเป็นมันวาวมากที่สุดสะท้อนแสงได้ดี มีสีเหลืองทอง และตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  (รูปที่ 5 ค) มีความมันวาวที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบที่อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  (รูปที่ 5 ข) มีลักษณะที่แตกต่างจากตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วตัวอย่างอื่นอย่างชัดเจน คือ มีลักษณะไม่มันวาวแต่มีความโปร่งแสงมีสีเหลืองทองเล็กน้อย จากผลของการถ่ายภาพนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอบด้วยอุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  สร้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อฟิล์มทองคำบนแก้ว ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  ยังไม่ปรากฏชัดเจนมากนักจากการถ่าย

ตัวอย่างฟิล์มทองบนชิลิกอน: ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนควบคุม (รูปที่ 5 ง) หรือ ตัวอย่างที่ไม่ได้อบมีลักษณะความเป็นมันวาวมากที่สุดสะท้อนแสงได้ดี มีสีเหลืองทอง และตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่อบที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  (รูปที่ 5 ฉ) มีความมันวาวที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบที่อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  (รูปที่ 5 จ) มีลักษณะที่แตกต่างจากตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วตัวอย่างอื่น คือ มีลักษณะหมองและไม่สะท้อนแสงดีเท่ากับตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอน จากผลของการถ่ายภาพนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอบด้วย

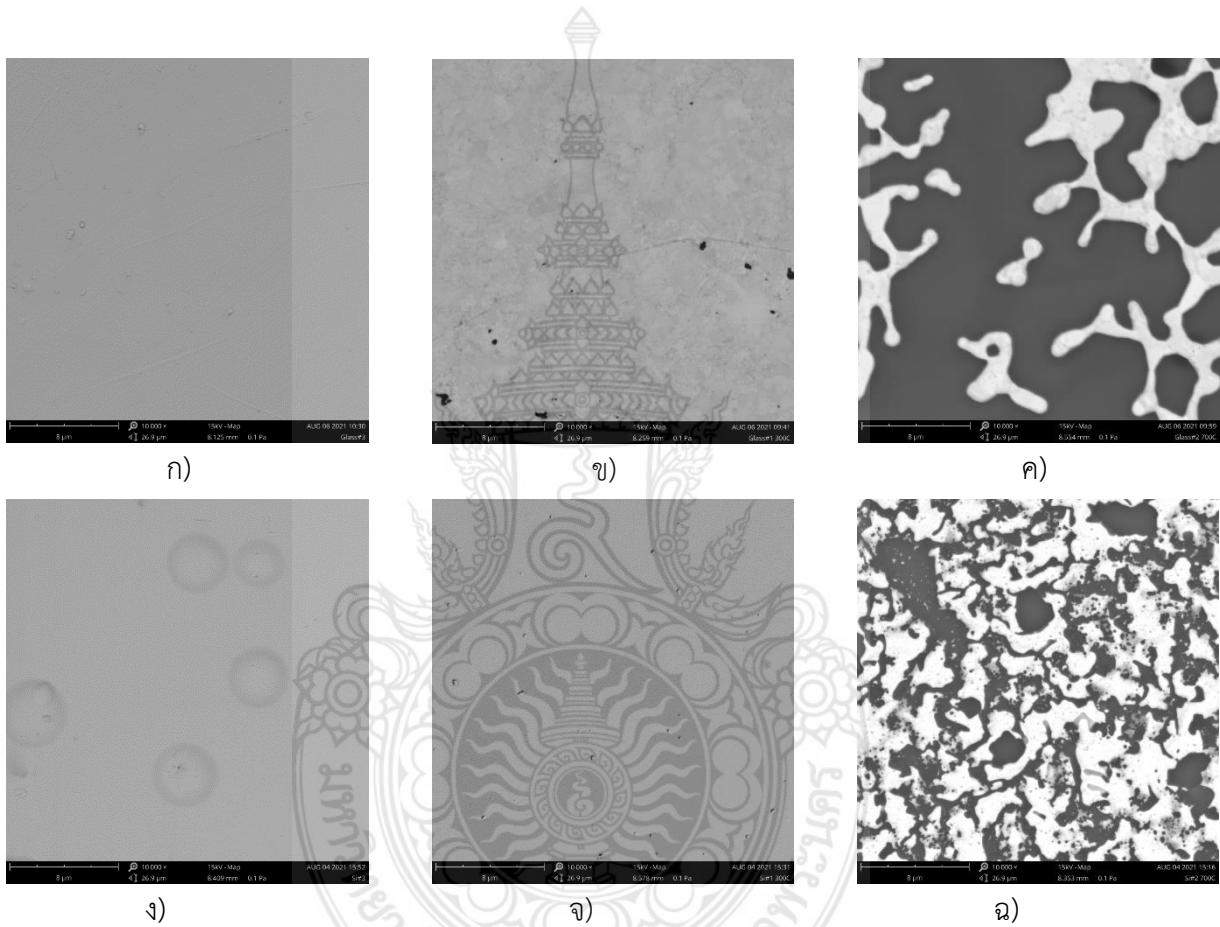
อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  สร้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อฟิล์มทองคำบนแก้ว ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  ยังไม่ปรากฏชัดเจนมากนักจากภาพถ่าย

เมื่อสังเกตุตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วเปรียบเทียบกับตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอน พบร่วมตัวอย่างทั้งสองชนิดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่สังเกตุได้จากภาพถ่ายมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการอบสูงขึ้นกล่าวคือ ตัวอย่างที่ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  ของทั้งฟิล์มทองคำบนแก้วและฟิล์มทองคำบนชิลิกอนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สามารถสังเกตุได้ชัดเจนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างในกลุ่มของตัวเอง ทั้งนี้ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่อบด้วยอุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  ไม่ปรากฏความชัดเจนเท่ากับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตุได้จากตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบด้วยอุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$



รูป 5 ภาพถ่ายตัวอย่างพิล์มทองคำด้วยกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Samsung Galaxy A50 ก) พิล์มทองบนแก้วไม่อบ ข) พิล์มทองบนแก้วอบที่  $700^{\circ}\text{C}$  ค) พิล์มทองบนแก้วอบที่  $300^{\circ}\text{C}$  จ) พิล์มทองบนชิลิกอนไม่อบ ฉ) พิล์มทองบนชิลิกอนอบที่  $700^{\circ}\text{C}$  หม) พิล์มทองบนชิลิกอนอบที่  $300^{\circ}\text{C}$

ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของหงษ์ตัวอย่างพิล์มทองคำที่ผลิตด้วยเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยพิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริง (Sputter Coater)



รูป 6 ภาพถ่ายของหงษ์ตัวอย่างพิล์มทองคำจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ก) พิล์มทองบนแก้วไม่อ่อน ข) พิล์มทองบนแก้วอบที่  $300^{\circ}\text{C}$  ค) พิล์มทองบนแก้วอบที่  $700^{\circ}\text{C}$  ง) พิล์มทองบนชิลิกอนไม่อ่อน จ) พิล์มทองบนชิลิกอนอบที่  $300^{\circ}\text{C}$  น) พิล์มทองบนชิลิกอนอบที่  $700^{\circ}\text{C}$

ในฟิล์มทองคำบนแก้ว จากการสังเกตุภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่า ฟิล์มทองคำบนแก้ว ตัวอย่างควบคุมหรือฟิล์มทองคำบนแก้วที่ไม่ได้ผ่านการอบ (รูปที่ 6 ก) มีความขุขะน้อยที่สุด ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบที่ อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  (รูปที่ 6 ข) มีความขุขะมากขึ้น และ ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบที่ อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  (รูปที่ 6 ค) มีความขุขะมากที่สุด ในด้านการครอบคลุมพื้นผิวของฟิล์มทองคำ ครอบคลุมพื้นผิว ของวัสดุฐานทั้งหมดในตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วควบคุม สำหรับตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วที่อบที่  $300^{\circ}\text{C}$  มี วัสดุพื้นฐานปริมาณเล็กน้อยปราบภูมิขึ้น และ ในตัวอย่างฟิล์มทองคำที่อบที่  $700^{\circ}\text{C}$  พบร่วงสตุพื้นฐาน โดยประมาณสามในสี่ปราบภูมิให้เห็น ซึ่งผลจากการสังเกตุความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของฟิล์มทองคำบนแก้วที่ ผ่านการอบที่อุณภูมิต่างๆจากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด สนับสนุนผลจากการสังเกตจาก ภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศ์เคลื่อนตามที่ควรจะเป็น แต่มีรายละเอียดมากกว่า กล่าวคือ ผลจากการสังเกตจาก จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าดทำให้สามารถสังเกตุการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่การอบตัวอย่างฟิล์มทองคำ บนแก้วที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  ได้ โดยสามารถสรุปได้ว่า การอบที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะทาง กายภาพในระดับจุลภาคของฟิล์มทองคำบนแก้ว

ในฟิล์มทองคำบนชิลิกอน ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนควบคุมหรือฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่ไม่ได้ผ่านการอบ (รูปที่ 6 ง) มีความขุขะของผิวต่ำสุด ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่อบที่  $300^{\circ}\text{C}$  (รูปที่ 6 จ) มีความขุขะมากขึ้น และ ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่อบที่  $700^{\circ}\text{C}$  (รูปที่ 6 ฉ) มีความขุขะมากที่สุด ในตัวอย่างฟิล์มทองคำ บนชิลิกอนควบคุมและตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่อบที่  $300^{\circ}\text{C}$  มีทองคำครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมด แต่พบว่า มีรูปร่างทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ  $3\text{-}5 \mu\text{m}$  ปราบภูมิอยู่บนตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนควบคุม ซึ่ง คณานุพัธจัยเชื่อว่ารูปร่างกลมเหล่านี้อาจเป็นสารอินทรีย์ที่ป่นเปื้อนตัวอย่าง เนื่องจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง เคมีพบว่า มีองค์ประกอบของราตุкар์บอนที่ไม่ควรมีอยู่บนตัวอย่างนี้ ในตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่ผ่านการ อบที่  $300^{\circ}\text{C}$  พบร่วงสตุพื้นผิวที่ไม่แน่นอนขนาดต่ำ ~ $0.5 \mu\text{m}$  จำนวนประมาณ 30 เกาะ กระจายตัวอยู่ทั่ว พื้นผิว และในตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่ผ่านการอบที่  $700^{\circ}\text{C}$  พบร่วงสตุพื้นผิวของวัสดุพื้นฐาน โดยประมาณหนึ่งในสี่ของพื้นผิวทั้งหมด ซึ่งผลจากการสังเกตุความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของฟิล์มทองคำบน ชิลิกอนที่ผ่านการอบที่อุณภูมิต่างๆจากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด สนับสนุนผลจากการ สังเกตจากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าดทำให้สามารถสังเกตุการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่การอบตัว

อย่างพิล์มทองคำบนชิลิกอนที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  ได้ โดยสามารถสรุปได้ว่า การอบที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพในระดับจุลภาคของพิล์มทองคำบนชิลิกอน

เมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าดของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนชิลิกอนด้วยกัน พบว่าตัวอย่างควบคุมของพิล์มทองคำบนแก้วและพิล์มทองคำบนชิลิกอนไม่มีความแตกต่างกันมากนักในลักษณะทางกายภาพทั่วไปของพิล์มแต่ ตัวอย่างพิล์มทองคำบนชิลิกอนปรากฏทรงกลมที่คาดว่ามาจากสารอินทรีย์ปนเปื้อน ที่การอบที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  พบว่า ตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วมีความขุ่นมากกว่าพิล์มทองคำบนชิลิกอน ในทำงเดียวกัน ที่การอบที่ อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  พบว่า ตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วมีความขุ่นมากกว่าพิล์มทองคำบนชิลิกอน และ การปรากฏของวัสดุพื้นฐานของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว (วัสดุพื้นฐานสามในสี่ของพื้นผิวทั้งหมดของตัวอย่าง) มีมากกว่า ตัวอย่างพิล์มทองคำบนชิลิกอน (วัสดุพื้นฐานหนึ่งในสี่ของพื้นผิวทั้งหมดของตัวอย่าง) ซึ่งผลการเปรียบเทียบนี้สนับสนุนจากการสังเกตภาพถ่ายของตัวอย่างทั้งสองด้วยภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศ์เคลื่อนที่ โดยสามารถสรุปได้ว่า การอบที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระดับจุลภาคกับตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนชิลิกอน โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการอบสูงขึ้น และที่อุณหภูมิเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระดับจุลภาคมากกว่าตัวอย่างพิล์มทองคำบนชิลิกอน

## ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)

ธาตุ	ความเข้มข้น เปอร์เซ็นต์			ความเข้มข้น เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก		
ตัวอย่าง	Au/Glass- Control	Au/Glass- $300^{\circ}\text{C}$	Au/Glass- $700^{\circ}\text{C}$	Au/Glass- Control	Au/Glass- $300^{\circ}\text{C}$	Au/Glass- $700^{\circ}\text{C}$
ทองคำ	98.11	97.90	35.27	99.73	99.70	85.76
ชิลิกอน	1.89	2.10	9.67	0.27	0.30	3.36
ออกซิเจน	-	-	55.08	-	-	10.89

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว แสดงการลดลงของความเข้มข้นของทองคำเมื่ออุณหภูมิในการอบต่างๆ

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว พบร่วมกับองค์ประกอบของธาตุส่วนใหญ่เป็นทองคำตามที่คาดไว้ โดยความเข้มข้นของทองคำ มีค่ามากสุดสำหรับตัวอย่างควบคุม และ มีค่าน้อยที่สุดในตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วที่ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  โดยมีค่าความเข้มข้น เป็น 98.11, 97.90, และ 35.27 หรือ 99.73, 99.70, และ 85.76 เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก ตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วควบคุม ตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วที่ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  และ  $700^{\circ}\text{C}$  ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าตัวอย่างทั้งสามมองค์ประกอบของธาตุซิลิกอนปรากวูญใน โดยความเข้มข้นของซิลิกอน น้อยที่สุดในตัวอย่างควบคุมของพิล์มทองคำบนแก้ว และ ความเข้มข้นมากที่สุดในตัวอย่างที่ผ่านการอบที่  $700^{\circ}\text{C}$  โดยมีค่าความเข้มข้น เป็น 1.89, 2.10, และ 9.67 หรือ 0.27, 0.30, และ 3.36 เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก สำหรับ ตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว ตัวอย่างควบคุม ตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วที่ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  และ  $700^{\circ}\text{C}$  ตามลำดับ สังเกตุได้ว่า ความเข้มข้นของทองคำในตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิสูงขึ้นมีปริมาณลดลง ในขณะที่ความเข้มข้นของธาตุซิลิกอน เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ใช้ในการอบตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลจากการสังเกตภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การปรากวูตัวของวัสดุฐาน(แก้ว) มีปริมาณมากขึ้นทำให้การวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) สามารถตรวจพบทองคำได้ลดลง และตรวจพบซิลิกอนจากแก้วได้มากขึ้น

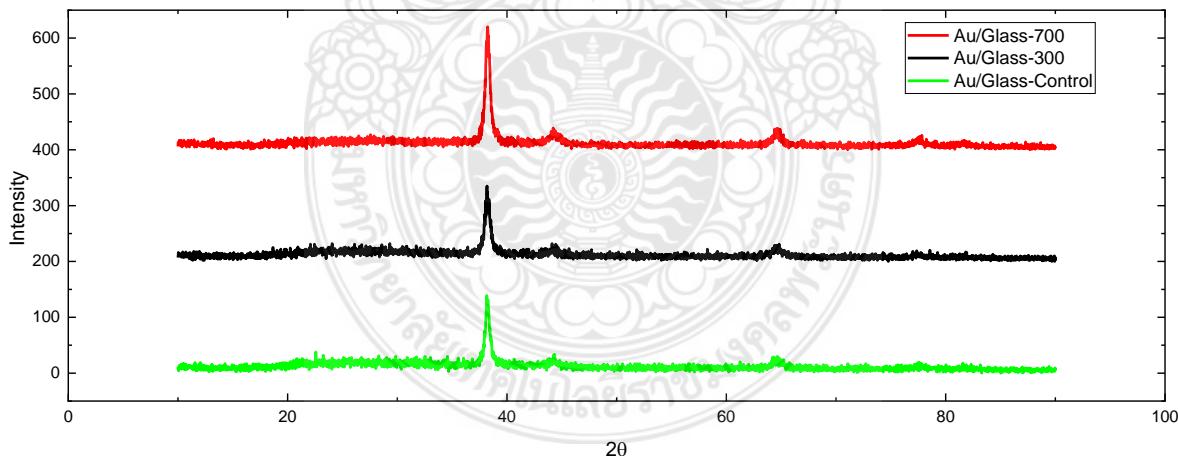
ธาตุ	ความเข้มข้น เปอร์เซ็นต์				ความเข้มข้นตามน้ำหนัก		
	Au/Si-Control	Au/Si-300	Au/Si700	Au/Si-Control	Au/Si-300	Au/Si700	
ทองคำ	94.28	93.79	74.32	99.37	99.06	95.97	
ซิลิกอน	2.56	6.21	16.64	0.39	0.94	3.07	
ออกซิเจน	-	-	9.13	-	-	0.96	
คาร์บอน	2.73	-	-	0.18	-	-	

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกา แสดงการลดลงของความเข้มข้นของทองคำ

เมื่ออุณหภูมิในการอบต่างๆ

## ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกของฟิล์มทองคำบนแก้วด้วยเทคนิก

จากการทดสอบโครงสร้างทางผลึกด้วยรังสีเอกซ์ ในฟิล์มทองคำบนแก้ว พบรังสัมตัวอย่างมีการแสดงตำแหน่งยอดที่ชัดเจน ที่มีมุ่ง สองซีต้า อุปที่ประมาณ  $38^\circ$ ,  $44^\circ$ , และ  $65^\circ$  สำหรับ ตัวอย่างควบคุม ตัวอย่างที่อบที่อุณหภูมิ  $300^\circ\text{C}$  และ ตัวอย่างที่อบที่อุณหภูมิ  $700^\circ\text{C}$  ตามลำดับ ซึ่งตำแหน่งยอดเหล่านี้ ตรงกับ โครงสร้างผลึกของทองคำ (111), (200), และ (220) โดยที่ ทั้งสามตัวอย่างของฟิล์มทองคำบนแก้วพบที่ยอดตำแหน่งประมาณ  $38^\circ$  มีความกว้างเต็มสูงสุดครึ่งหนึ่งของยอดต่าที่สุดและมีพื้นที่ใต้ยอดสูงสุด เมื่อเทียบกันระหว่างตำแหน่งยอดทั้งสาม เป็นหลักฐานว่าฟิล์มทองคำบนแก้วทั้งสามตัวอย่าง มีผลึกทองคำในโครงสร้าง (111) เป็นหลักเนื่องจาก ความกว้างเต็มสูงสุดครึ่งหนึ่งบวกถึงความเป็นผลึกที่มีคุณภาพสูง(มีความใกล้เคียงการเป็นผลึกเดียว) และ พื้นที่ใต้ยอดบวกปริมาณของโครงสร้างที่มีอยู่บนตัวอย่าง เมื่อสังเกตุแนวโน้มตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การอบ พบร่วมเมื่อทำการอบและเพิ่มอุณหภูมิในการอบแล้ว ทั้งความกว้างเต็มสูงสุดและพื้นที่ใต้ยอดที่ตำแหน่งประมาณ  $38^\circ$  มีการเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของการอบ ซึ่งหมายความว่า การเพิ่มอุณหภูมิการอบ ทำให้ปริมาณของโครงสร้างผลึกทองคำ (111) ในชิ้นงานฟิล์มทองคำบนแก้วเพิ่มขึ้นและคุณภาพของผลึกลดลง(มีความเป็นพหุผลึกมากขึ้น)



รูป 7 ผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้ว

	Peak Center			
	Au/Glass-Control	Au/Glass-300	Au/Glass-700	
Peak 1	38.23±0.01	38.22±0.01	38.12±0.01	Au (111)[4][5]
Peak 2	44.19±0.06	44.25±0.06	44.14±0.05	Au (200)[5]
Peak 3	64.65±0.04	64.64±0.04	64.68±0.03	Au (220)[5]
Peak 4	-	-	-	

ตาราง 3 สรุปค่าตำแหน่งจุดศูนย์กลางของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว

	FWHM		
	Au/Glass-Control	Au/Glass-300	Au/Glass-700
Peak 1	0.59±0.01	0.64±0.01	0.71±0.01
Peak 2	1.12±0.13	1.05±0.13	1.16±0.13
Peak 3	1.22±0.09	1.30±0.09	0.96±0.07
Peak 4	-	-	-

ตาราง 4 สรุปค่าความกว้างเต็มสูงสุดครึ่งหนึ่งของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว

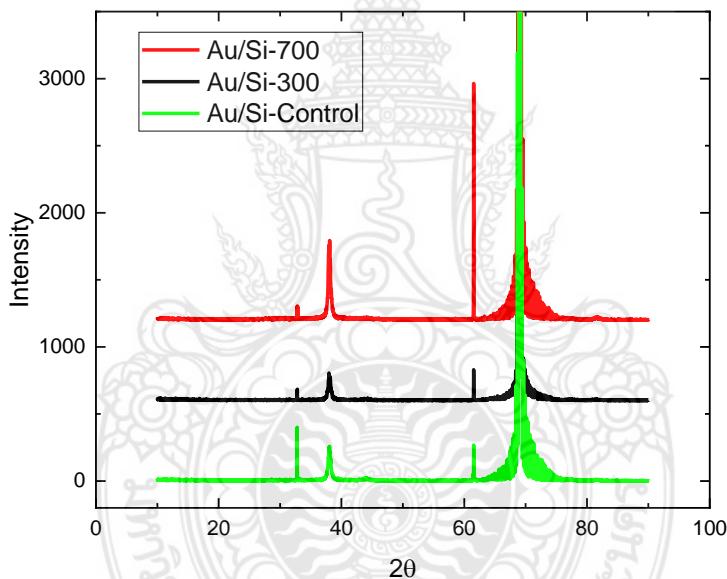
	Peak Area		
	Au/Glass-Control	Au/Glass-300	Au/Glass-700
Peak 1	64.64±0.25	67.33±0.75	160.10±1.52
Peak 2	9.86±1.05	8.55±0.98	12.59±1.19
Peak 3	16.44±1.11	18.19±1.12	21.29±1.31
Peak 4	-	-	-

ตาราง 5 สรุปค่าพื้นที่ไดกราฟของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้ว

	Peak Center			
	Peak Center	FWHM	Area	Assignment
Au/Si-Control	$69.17 \pm 0.01$	$0.04 \pm 0.01$	$3522.36 \pm 32.34$	Si(100) [6]
Au/Si-300	$69.07 \pm 0.02$	$0.34 \pm 0.01$	$2909.13 \pm 36.58$	Si(100) [6]
Au/Si-700	$69.01 \pm 0.01$	$0.06 \pm 0.01$	$3919.20 \pm 38.80$	Si(100) [6]

ตาราง 6 สรุปค่าตำแหน่งจุดศูนย์กลางของยอดของ Si(100) ที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอน

### ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึก ของ พิล์มทองคำบนซิลิกอน



รูป 8 ผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอน

ผลการทดสอบของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนทั้งสาม ปรากฏว่ามียอดที่ตำแหน่งประมาณ  $69^{\circ}$  อย่างชัดเจนซึ่งเป็นไปตามที่คาดเดือนจากในขั้นกลุ่มนี้ วัสดุฐานคือ ซิลิกอน (100) (Chi 2016) ดังนั้นผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจเพิ่มเติมกับยอดที่ตำแหน่งนี้เป็นพิเศษ หากแต่ว่ายอดนี้นับว่ามีความเข้มมากเป็นพิเศษทำให้ยอดอื่นๆของตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนปรากฏไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการตัดและขยายผลของการเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มบนแก้วใหม่ดังรูปที่ 7 ซึ่งทำให้สามารถสังเกตเห็นยอดอีกสามตำแหน่งที่มุมสองซีด้านประมวล 33°, 38°, และ 62° ตามลำดับ ซึ่งยอดที่มุม 38° ตรงกับโครงสร้างผลึกทองคำ (111) โดย

พบว่าพื้นที่ใต้กราฟของ ยอดที่มุน  $38^{\circ}$  มีค่าลดลง จากตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนควบคุม เมื่อตัวอย่างฟิล์ม ทองคำบนชิลิกอนถูกอบที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  และเมื่อทำการอบตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  พบว่าพื้นที่ใต้กราฟของยอดมุนที่  $38^{\circ}$  กับมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใต้กราฟกับอุณหภูมิ เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของค่าความกว้างเต็มสูงสุดครึ่งหนึ่งของยอดมุนที่  $38^{\circ}$  โดยค่าความกว้างเต็มสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นจากตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนควบคุม เมื่อตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนถูกอบที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  และเมื่อทำการอบตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนที่อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  พบว่าค่าความกว้างเต็มสูงสุดมีค่าลดลง ซึ่งหมายความว่า ปริมาณความเข้มข้นขององค์ในโครงสร้างผลึก (111) ลดลงในตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนเมื่อผ่านการอบที่  $300^{\circ}\text{C}$  และเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการอบที่  $700^{\circ}\text{C}$  และคุณภาพผลึก หรือความเป็นผลึกเชิงเดี่ยวขององค์ (111) ตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนเมื่อผ่านการอบที่  $300^{\circ}\text{C}$  และเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการอบที่  $700^{\circ}\text{C}$  ทั้งนี้มุนยอดที่  $33^{\circ}$  และ  $62^{\circ}$  ไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้

	Peak Center			
	Au/Si-Control	Au/Si-300	Au/Si-700	Assignment
Peak 1	$32.79 \pm 0.01$	$32.86 \pm 0.01$	$32.85 \pm 0.01$	ไม่ทราบแน่นอน
Peak 2	$38.04 \pm 0.01$	$38.17 \pm 0.01$	$38.03 \pm 0.01$	Au (111)
Peak 3	$61.55 \pm 0.01$	$61.66 \pm 0.24$	$61.54 \pm 0.01$	ไม่ทราบแน่นอน

ตาราง 7 สรุปค่าตำแหน่งจุดศูนย์กลางของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนโดยไม่ร่วมยอดของ Si(100)

	FWHM		
	Au/Si-Control	Au/Si-300	Au/Si-700
Peak 1	$0.03 \pm 0.01$	-	$0.14 \pm 0.03$
Peak 2	$0.58 \pm 0.01$	$0.69 \pm 0.01$	$0.51 \pm 0.01$
Peak 3	$0.04 \pm 0.01$	$1.62 \pm 0.58$	$0.04 \pm 0.01$

ตาราง 8 สรุปค่าความกว้างเต็มสูงสุดครึ่งหนึ่งของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนโดยไม่ร่วมยอดของ Si(100)

	Area		
	Au/Si-Control	Au/Si-300	Au/Si-700
Peak 1	12.59±0.20	-	7.26±1.38
Peak 2	131.00±0.90	104.02±1.55	284.27±2.64
Peak 3	11.11±0.02	7.62±2.43	73.46±0.71

ตาราง 9 สรุปค่าพื้นที่ใต้กราฟของยอดที่พบในผลการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนชิลิกอนโดยไม่ร่วมยอดของ Si(100)



## บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การผลิตตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนจากทองคำเปลวไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจาก เนื่องจากทองคำเปลวไม่สามารถยึดติดกับสีฐานได้มากพอที่จะนำตัวอย่างไปทำการทดสอบเพื่องานวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีในการผลิตพิล์มทองคำ จากการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียผู้วิจัยตัดสินใจ การผลิตตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนด้วยเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยพิล์มบางแบบสปัตเตอร์ริง (Sputter Coater) โดยการใช้พื้นที่ว่างของช่องเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ไอทองคำที่เหลือใช้จากการเตรียมตัวอย่างอื่นๆ ซึ่งทำให้สามารถผลิตตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนซึ่งสามารถนำไปทำการทดสอบต่อไปได้

ผลจากการสังเกตุภาพถ่ายของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่ออุณหภูมิการอบเพิ่มขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$  เท่านั้นสำหรับตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอน ในขณะที่ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบซ่องกราด แสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระดับจุลภาคของตัวอย่างพิล์มทองคำทั้งสองไปในแนวทางเดียวกันกับภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศ์เคลื่อนที่แต่มีรายละเอียดมากกว่า โดยผลของการถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงให้เห็น การรวมตัวกันของพิล์มทองคำทำให้สีฐานปรากฏมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิการอบเพิ่มสูงขึ้น ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนยืนยันผลของการถ่ายภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งผลของการถ่ายจากกล้องโทรทรรศ์เคลื่อนที่ ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และ การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรวมกันเป็นหยดในสถานะของแข็งของพิล์มทองคำ เมื่ออุณหภูมิการอบสูงขึ้นจาก  $300^{\circ}\text{C}-700^{\circ}\text{C}$  โดยกระบวนการรวมกันเป็นหยดในสถานะของแข็งเกิดขึ้นในตัวอย่างพิล์มทองคำมากกว่าตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอน เมื่อใช้อุณหภูมิในการอบเท่ากัน

ผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างพิล์มทองคำบนซิลิกอนพบว่า มีโครงสร้างทางผลึก สามโครงสร้างได้แก่ ทองคำโครงสร้าง (111) (200) และ (220) โดยโครงสร้างทองคำ (111) มีมากที่สุด เมื่อทำการอบตัวอย่างพิล์มทองคำบนแก้วจากอุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}-700^{\circ}\text{C}$  พบร่วมกับความเข้มของและความเป็นผลึกเชิงเดี่ยวของ โครงสร้างทองคำ (111) เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ ในตัวอย่างพิล์มทองคำ

บันชิลิกอนพบว่า มีโครงสร้างทางผลึกของทองคำ (111) เพียงโครงสร้างเดียว เมื่อทำการอบตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วจากอุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$ - $700^{\circ}\text{C}$  พบว่าความเข้มของและความเป็นผลึกเชิงเดี่ยวของ โครงสร้างทองคำ (111) ลดลงที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  และ เพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิ  $700^{\circ}\text{C}$

จากการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าการอบตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของฟิล์มทองคำผ่านกระบวนการร่วมกันเป็นหยดในสถานะของแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางผลึกของทองคำได้อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของทองคำในระดับอะตอม โดยกลไกในการเคลื่อนที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นดังนี้ การให้ความร้อนกระตุ้นให้ทองคำมีพลังงานมากขึ้นแล้วเกิดการเคลื่อนที่แบบชุ่นมากขึ้นแล้วประพฤตัวในสถานะหลอมเหลว (molten) เพื่อทำการลดพลังงานพื้นผิวของทองคำในตัวอย่างฟิล์มทองคำ ทองคำจึงเกิดการจับตัวกันผ่านกระบวนการรวมตัวเป็นหยดในสถานะของแข็ง พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง แม้ว่าอุณหภูมิในงานวิจัยนี้จะน้อยกว่าจุดหลอมเหลวของทองคำก็ตาม ซึ่งการที่ฟิล์มทองคำสามารถประพฤติตัวเหมือนหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวอาจเนื่องมาจาก ความหนาของฟิล์มทองคำที่มีค่าต่ำ สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางผลึกมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเย็นตัวของตัวอย่างฟิล์มหลังการอบ เพราะตัวอย่างฟิล์มทั้งหมดในการวิจัยนี้ถูกปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างช้าในเตาอบ ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการปลูกผลึก ดังนั้นกระบวนการนี้อาจส่งผลให้เกิดการปลูกผลึกที่มีมากที่สุดของทองคำบนตัวอย่างฟิล์มทองคำ ซึ่งได้แก่ทองคำในหโครงสร้าง (111) ให้เพิ่มมากขึ้นได้ ทั้งนี้ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อกลไกการเคลื่อนที่ของทองคำในตัวอย่างฟิล์มทองคำคือ อัตโนมัติการระหว่างฟิล์มทองคำและวัสดุฐานราก ซึ่งเห็นได้จากการทดลองที่แตกต่างกันของตัวอย่างฟิล์มทองคำบนแก้วและตัวอย่างฟิล์มทองคำบนชิลิกอน

## ເອກສາຮ້າງອົງ

- [1] J. I. Langford and A. J. C. Wilson, “Scherrer after sixty years: A survey and some new results in the determination of crystallite size,” *J. Appl. Crystallogr.*, vol. 11, no. 2, pp. 102–113, Apr. 1978, doi: 10.1107/S0021889878012844.
- [2] O. C. Ernst, D. Uebel, S. Kayser, F. Lange, T. Teubner, and T. Boeck, “Revealing all states of dewetting of a thin gold layer on a silicon surface by nanosecond laser conditioning,” *Appl. Surf. Sci. Adv.*, vol. 3, no. December 2020, p. 100040, 2021, doi: 10.1016/j.apsadv.2020.100040.
- [3] A. B. Tesler, B. M. Maoz, Y. Feldman, A. Vaskevich, and I. Rubinstein, “Solid-state thermal dewetting of just-percolated gold films evaporated on glass: Development of the morphology and optical properties,” *J. Phys. Chem. C*, vol. 117, no. 21, pp. 11337–11346, 2013, doi: 10.1021/jp400895z.
- [4] X. Zhang, X. H. Song, and D. L. Zhang, “Thickness dependence of grain size and surface roughness for dc magnetron sputtered Au films,” *Chinese Phys. B*, vol. 19, no. 8, 2010, doi: 10.1088/1674-1056/19/8/086802.
- [5] S. S. Godipurge *et al.*, “A facile and green strategy for the synthesis of Au, Ag and Au–Ag alloy nanoparticles using aerial parts of *R. hypocrateriformis* extract and their biological evaluation,” *Enzyme Microb. Technol.*, vol. 95, no. October 2017, pp. 174–184, 2016, doi: 10.1016/j.enzmictec.2016.08.006.
- [6] T. T. K. Chi, N. T. Le, B. T. T. Hien, D. Q. Trung, and N. Q. Liem, “Preparation of SERS Substrates for the Detection of Organic Molecules at Low Concentration,” *Commun. Phys.*, vol. 26, no. 3, p. 261, 2017, doi: 10.15625/0868-3166/26/3/8053.



# ประวัตินักวิจัย

## หัวหน้าโครงการ

### 1. ชื่อ-นามสกุล

(ภาษาไทย) ภูมิรัตน์ นวรัตน์

(ภาษาอังกฤษ) Poomirat Nawarat

### 2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

### 3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ศูนย์พระนครเหนือ) เลขที่ 1381 ถนนประชาธิรักษ์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8245755

ไประษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [poomirat.n@rmutp.ac.th](mailto:poomirat.n@rmutp.ac.th)

### 4. ประวัติการศึกษา

Bachelor of Art in Physics and Computer Science: Middlebury College, Middlebury VT,  
USA

Master of Science in Physics: Rensselaer Polytechnic Institute, Troy NY, USA

Doctor of Philosophy in Physics: Rensselaer Polytechnic Institute, Troy NY, USA

### 5. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

-Scanning Electron Microscopy

-Atomic Force Microscopy

-Molecular Electronics

-Chemical Vapor Deposition

-Electron Beam lithography

-Thermal Evaporation Deposition

## 6. ประสบการณ์งานวิจัย

- P. Nawarat, K. Beach, V. Meunier, H. Terrones, G.-C. Wang, K. M. Lewis, “Voltage-Dependent Barrier Height of Electron Transport through Iron Porphyrin Molecular Junctions” *J. Phys. Chem. C*, vol. 125, pp. 7350–7357, Mar. 2021.
- B. Wang, P. Nawarat, K. M. Lewis, P. Patsalas, and D. Gall, “Tunable Infrared Plasmonic Properties of Epitaxial  $Ti_{1-x}Mg_xN(001)$  Layers” *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 13, pp. 22738-22748, May 2021.
- J. Littlejohn , Z. Li, Z. Lu, X. Sun, P. Nawarat, Y. Wang, Y. Li, T. Wang, Y. Chen, L. Zhang, H. Li, K. Kisslinger, S. Shi, J. Shi, A. Raeliarijaona, W. Shi, H. Terrones, K. M. Lewis, M. Washington, T. M. Lu, and G.-C. Wang, “Large metallic vanadium disulfide ultrathin flakes for spintronic circuits and quantum computing devices,” *ACS Appl. Nano Mater.*, vol. 2, no. 6, pp. 3684–3694, Jun. 2019.
- P. Nawarat (Presenter), K. Beach, H. Terrones, G.-C. Wang, and K. M. Lewis, “Transition of Conduction Mechanism from Direct Tunneling to Fowler-Nordheim Tunneling in Iron Porphyrin (FeP) Molecular Junction”, Howard-Columbia Collaboration Meeting, Columbia University, New York City, NY, USA, May. 2019. (Poster presentation)
- P. Nawarat (Presenter), Z. Li, D. Frey, G.-C. Wang, and K. M. Lewis, “Characterization of the Metallic Property of Vanadium Disulfide ( $VS_2$ )”, American Vacuum Society Spring, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA, Jun. 2017. (Poster presentation)
- P. Nawarat (Presenter), “15 Degrees Celsius in 15 Minutes: Optimal Temperature for Boost Laser”, Summer symposium, Middlebury College, Middlebury, VT, USA, Aug. 2013. (Poster presentation)